

Misura della caratteristica I-V di un transistor BJT

Matteo Bonazzi, Massimo D'Alessandro Schmidt

December 1, 2022

Abstract

Misura della caratteristica I-V di un transistor BJT in configurazione emettitore comune, in due valori differenti della corrente di base

Dal fit lineare dei dati nella regione attiva, si ottengono i parametri $V_{Early} = e R =$.

1 Introduzione

2 Dati

Nella configurazione con $I_b = 200\mu A$, si misurano i seguenti valori per V_{ce} e I_c :

V_{ce} (mV)	Errore V (mV)	Risoluzione (mV)	Fondo scala (mV/div)	I_c (mA)	errore I_c (mA)	Risoluzione (mA)	Fondo scala (mA)
4000	160	200	1000	36.9	0.18	0.1	200
3800	150	200	1000	36.5	0.18	0.1	200
3600	150	200	1000	36	0.18	0.1	200
3400	143	200	1000	35.6	0.18	0.1	200
3200	139	200	1000	35.1	0.18	0.1	200
3000	135	200	1000	34.7	0.17	0.1	200
2900	100	200	1000	34.6	0.17	0.1	200
2700	95	200	1000	34.2	0.17	0.1	200
2500	90	100	500	33.6	0.17	0.1	200
2400	88	100	500	33.6	0.17	0.1	200
2200	83	100	500	33.1	0.17	0.1	200
2000	78	100	500	32.5	0.16	0.1	200
1900	76	100	500	32.5	0.16	0.1	200
1700	71	100	500	32	0.16	0.1	200
1500	67	100	500	31.4	0.16	0.1	200
1400	65	100	500	31.2	0.16	0.1	200
1200	41	40	200	30.8	0.15	0.1	200
1120	39	40	200	30.6	0.15	0.1	200
1000	36	40	200	30.2	0.15	0.1	200
800	31	40	200	29.8	0.15	0.1	200
720	29	40	200	28.9	0.14	0.1	200
500	18	20	100	26.5	0.13	0.1	200
400	16	20	100	24.4	0.12	0.1	200
300	10	10	50	22	0.11	0.1	200
200	7.8	10	50	17.08	0.085	0.01	20
50	5.2	10	50	4.5	0.0225	0.01	20

Nella configurazione con $I_b = 200\mu A$, si misurano i seguenti valori per V_{ce} e I_c :

3 *Analisi dati*